

ایجاد سیلیکون سیاه با استفاده از تپ‌های لیزری فمتوثانیه با شار انرژی‌های مختلف

رضا گودرزی، فرشته حاج‌اسماعیل‌بیگی، افتخار بستان دوست، حسین رزاقی، اسما معتمدی

پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهران

چکیده - در این پژوهش با استفاده از تپ‌های لیزر فمتوثانیه، سطح ویفر سیلیکون تابش داده شده است. شار انرژی تپ‌های لیزری به عنوان یک مشخصه‌ی مهم مورد مطالعه قرار گرفته و به ازای سه شار انرژی ۱، ۳ و ۹ کیلوژول بر مترمربع، بیناب بازتابی لیزر از سطح ویفر سیلیکون پس از ۱ دقیقه تابش‌دهی ثبت شده است. نتایج نشان می‌دهد که در شار انرژی لیزری پایین، کندوسوز به‌طور مؤثر رخ نداده و میزان بازتاب از سطح تغییری نکرده است. کندوسوز لیزری در شار انرژی لیزر مربوط به آستانه‌ی تشکیل پلاسمای یونی رخ می‌دهد که در نتیجه‌ی آن ساختارهای میخه مانند روی سطح سیلیکون تشکیل می‌شوند. تغییر ساختار روی سطح منجر به کاهش میزان بازتاب از آن می‌شود. در نتیجه، با تابش‌دهی لیزری سطح ویفر سیلیکون در محدوده انرژی بیش از شار آستانه، سیلیکون سیاه ایجاد شده که به دلیل جذب بالای آن قابلیت بهبود فناوری ساخت سلول‌های خورشیدی را دارد.

کلید واژه- لیزر فوق‌کوتاه، بازتاب سطحی، سیلیکون سیاه، کندوسوز لیزری

Fabrication of black silicon by using femtosecond laser pulses at various fluencies

Reza Goodarzi, Freshteh Hajiesmaeilbaigi, E. Bostandoost, H. Razaghi, A. Motamedi

Photonics and Quantum Technologies Research School, NSTRI, Tehran, IRAN

Abstract- In this research, a silicon wafer has been irradiated by femtosecond laser pulses. Laser fluence is studied as an important parameter. The reflection spectrum of the surface at three different fluencies 1, 3 and 9 KJ/m² has been recorded after 1-minute irradiation. The results are shown that at low laser fluence the efficient ablation did not take place and the surface reflection did not change. However, when the laser fluence reaches to ionic plasma formation threshold, the laser ablation is occurring that cause spikes formation on the silicon surface. The changes in the surface structure result in reflection decreases. In conclusion, by laser irradiation of silicon surface with laser fluence more than the threshold the black silicon is fabricated which due to its high absorption can improve the manufacture of solar cell technology.

Keywords: Ultrashort pulse laser, surface reflection, black silicon, laser ablation

۱- مقدمه

پس از ساخت نخستین لیزر در سال ۱۹۶۰، فرآیند پردازش مواد با لیزر به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. امروزه لیزر به عنوان یک ابزار مفید در صنایع مختلف به کار گرفته می شود.

برای ایجاد میکروساختاری خاص، به لیزری با ویژگی های مشخص نیاز است. به عنوان مثال، برای ساخت مواد میکرومتری از جنس سرامیک و پلیمر، لیزرهای اگزایمر استفاده می شوند و برای مته کاری میکرومتری لیزر Nd:YAG مورد استفاده قرار می گیرد [۱]. در بسیاری از مواردی که نیازمند دقت بسیار بالایی می باشند، مانند ایجاد ساختارهای میکرومتری روی فلزات، استفاده از تپ های لیزری میکروثانیه و حتی نانوثانیه به دلیل تخریب مکانیکی و حرارتی که ایجاد می کند، نمی تواند پاسخ گوی نیاز صنعت باشد.

استفاده از تپ های لیزری فوق کوتاه به دلیل آن که تخریب ناشی از پخش حرارتی به حداقل می رسد، می تواند گزینه ی مناسبی باشد [۱]. تحقیقات نشان داده است که لیزرهای فمتوثانیه می توانند ابزاری عالی برای ایجاد ساختارهای میکرومتری باشند و جهت میکروماشین کاری فلزات، نیمه رساناها، دی الکتریک ها، پلیمرها و ... مورد استفاده قرار بگیرند.

۲- نظریه ی اندرکنش تپ های فوق کوتاه با ماده

اهمیت و ظرفیت بالای استفاده از تپ لیزر فوق کوتاه برای میکروماشین کاری در این نکته نهفته است که با استفاده از چنین تپی می توان پخش گرمایی را کمینه کرد و عمق نفوذ نوری مشخصه ی تأثیرگذار در اندرکنش خواهد بود. انرژی لیزر در ابتدا توسط الکترون ها جذب می شود و سپس از طریق برخورد بین الکترون با فونون، انرژی لیزر به شبکه منتقل می گردد. زمان انتقال انرژی از الکترون ها به شبکه در حدود ۱۰ پیکوثانیه است [۲]. لذا اگر از تپی با مدت زمان کمتر از ۱۰ پیکوثانیه استفاده شود، ماده زمان لازم برای انتقال حرارت را نخواهد داشت و اثرات حرارتی به حداقل می رسند. از سوی دیگر، به دلیل آن که اتلاف حرارتی نسبت به تپ های طولانی کم است، آستانه ی شار انرژی لیزری مورد نیاز نیز کاهش می یابد. در نتیجه می-

توان از تپ های فوق کوتاه با انرژی کمتری نسبت به تپ ها کوتاه استفاده کرد. علاوه بر موارد گفته شده، شدت بالای تپ های لیزری فوق کوتاه منجر به تأثیرگذاری بیشتر فرآیندهای غیرخطی مورد نیاز در میکروماشین کاری مواد شفاف می شود.

اگر تپ های فوق کوتاه به سطح ماده برخورد کنند و جذب شوند، پدیده ی کندوسوز لیزری رخ می دهد که به معنی جدا شدن مواد از سطح هدف در اثر انتقال انرژی لیزر به ماده است. پس از اتمام اندرکنش و سرد شدن سطح، ساختارهایی به صورت خودبه خودی روی سطح شکل می گیرند که انواع مختلفی دارند و معروف ترین آن ها نوارها و میخه ها هستند [۳].

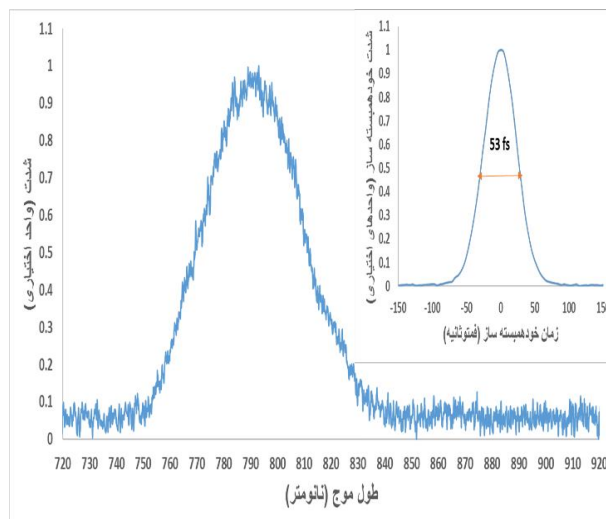
ایجاد ساختارهای میخه مانند روی سطح سیلیکون می تواند ضریب جذب سیلیکون را از طریق افزایش تعداد دفعات بازتاب به سطح افزایش دهد. سیلیکون دارای میخه ها، سیلیکون سیاه نیز نامیده می شود چرا که تقریباً تمام نور در محدوده ی مرئی و مادون قرمز نزدیک را جذب می کند. سیلیکون سیاه در سلول های خورشیدی به منظور افزایش بازده آن ها به کار می رود [۴].

در این پژوهش، اثر تپ های لیزر فمتوثانیه روی ویفر سیلیکون مطالعه شده است. تغییرات حاصل شده در بازتاب نوری سطح درحین تابش لیزر، اندازه گیری شده و ساختار شکل گرفته روی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است.

۳- روش انجام کار

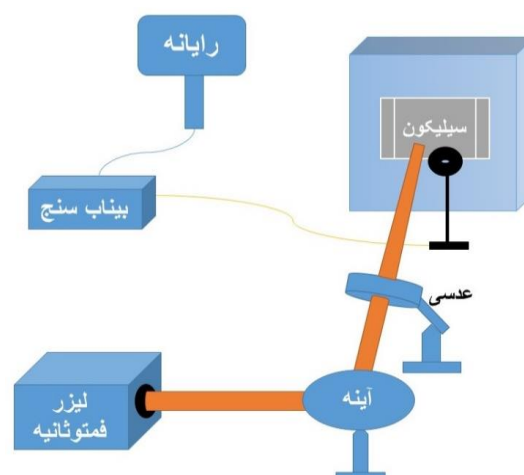
برای انجام آزمایش ها از یک لیزر فمتوثانیه با محیط فعال تیتانیوم-سفایر استفاده شده است. تپ های لیزر به شکل گوسی، دارای مدت زمان ۵۳ فمتوثانیه و طول موج مرکزی ۷۹۰ نانومتر می باشند که نرخ تکرار آن ۱۰ هرتز است. خروجی نوسانگر لیزر با روش چرپ کردن در تقویت کننده باز تولیدی تقویت شده و تا انرژی ۵۰۰ میلی ژول قابلیت افزایش انرژی دارد. در شکل ۱ پهنای بینایی و پهنای زمانی تپ های لیزری، نشان داده شده است.

انتخاب شده و کندوسوز با شار انرژی مشخص انجام می-شود. بیناب بازتابی نمونه‌ها به‌طور هم‌زمان قبل و بعد از ۶۰ ثانیه تابش‌دهی توسط بیناب‌سنج فیبر نوری با دقت 0.6nm (melles Griot 13Fos-100) به ثبت رسیده است. با توجه به آن که نرخ تکرار لیزر ۱۰ هرتز می‌باشد، در مدت یک دقیقه، ۶۰۰ تپ لیزری به سطح ویفر سیلیکون برخورد نموده‌اند. با توجه به این که انرژی در هر مرحله افزایش یافته است، اثری که تپ‌های متوالی لیزر فمتوثانیه در هر مرحله از آزمایش روی سطح می‌گذارند نیز از یکدیگر متمایز خواهد بود، در شکل ۳ بیناب بهنجار شده-ی بازتابی نمونه‌ها، مورد مقایسه قرار گرفته است.



شکل ۱: بیناب و پهنای تپ لیزر مورد استفاده قرار گرفته

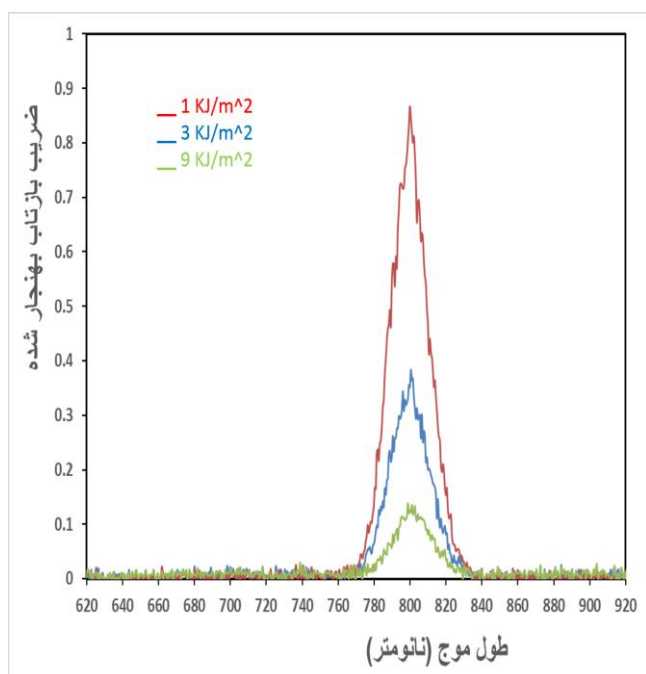
هدف مورد استفاده در این مقاله، ویفر سیلیکون آلائیده‌ی نوع n با اندیس میلر (۱۱۱) می‌باشد که یک طرف آن جلا داده شده است. تپ‌های لیزر فمتوثانیه با استفاده از عدسی با فاصله‌ی کانونی ۸۵ میلی‌متر، مطابق شکل ۲ روی سطح جلا داده نشده‌ی هدف، متمرکز می‌شوند.



شکل ۲: طرح‌واره‌ی آزمایش

انرژی تپ‌های لیزر با استفاده از انرژی‌متری با دقت $1\mu\text{J}$ به نحوی انتخاب گردید که با توجه به پهنای باریکه‌ی لیزر پس از متمرکز شدن توسط عدسی، $2W_0=150\mu\text{m}$ ، شار انرژی‌هایی در حدود ۱، ۳ و ۹ کیلوژول بر متر مربع را نتیجه می‌دهد. شار انرژی 3 KJ/m^2 کمی بیشتر از شار آستانه‌ی مورد نیاز برای کندوسوز سیلیکون می‌باشد [۳].

در هر نوبت پرتوده‌ی، یک نقطه از سطح ویفر سیلیکون

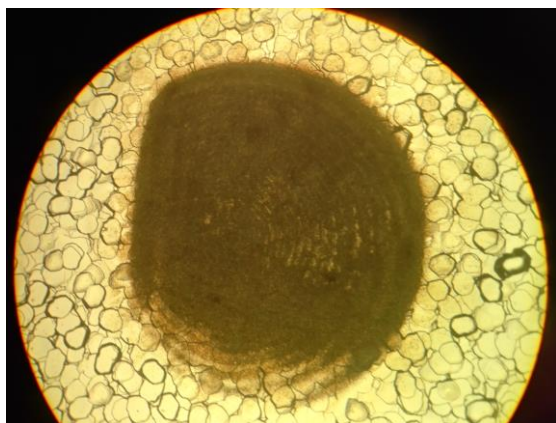


شکل ۳: بیناب بازتابی از سطح به ازای کندوسوز لیزری با شار انرژی‌های مختلف

۴- تحلیل نتایج

اگر از تپ با شار انرژی 1 KJ/m^2 استفاده شود، با توجه به آن که شار انرژی لیزر کم‌تر از آستانه‌ی کندوسوز است، جذب انرژی لیزر نمی‌تواند منجر به تغییر ریخت‌شناسی سطح شود و لذا سطح ماده دست‌نخورده باقی می‌ماند و ضریب جذب نیز تغییر محسوسی نمی‌کند.

همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، هنگامی که شار انرژی لیزر کمی بیشتر از آستانه‌ی کندوسوز سیلیکون ($2/8\text{ KJ/m}^2$) باشد، درصد بازتاب سطحی نسبت



شکل ۵: تصویر گرفته شده با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر از سطح ویفر سیلیکون، پس از تابش با شار انرژی 9 KJ/m^2

۵- نتیجه گیری

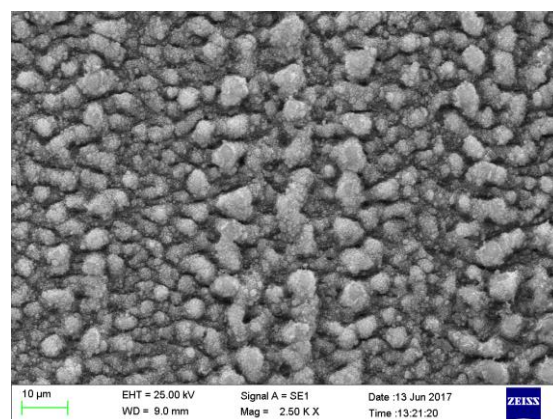
در این پژوهش نشان داده شد که با استفاده از تابش دهی سطح ویفر سیلیکون با باریکه لیزر فمتوثانیه در شار انرژی که منجر به انفجار فاز می شود، می توان سیلیکون سیاه تولید کرد که جذب آن در ناحیه ی طول موجی مادون قرمز نزدیک به مراتب افزایش یابد. از سیلیکون سیاه می توان برای ساخت سلول های خورشیدی استفاده کرد که در این صورت بازده جذب آن ها افزایش می یابد.

مراجع

- [1] Fermann, M. E., Galvanauskas, A., & Sucha, G. (Eds.). (2002). *Ultrafast lasers: Technology and applications* (Vol. 80). CRC Press.
- [2] Rafael R. Gattass and Eric Mazur, "Femtosecond laser micromachining in transparent materials", *Nature*, Vol. 2, pp. 219-225, 2008.
- [3] Bonse, Jörn, et al. "Femtosecond laser ablation of silicon—modification thresholds and morphology." *Applied Physics A: Materials Science & Processing* 74.1 (2002): 19-25.
- [4] Sarnet, T., et al. "Femtosecond laser for black silicon and photovoltaic cells." *Proc. SPIE*. Vol. 6881. 2008.
- [5] Campbell, Patrick, and Martin A. Green. "Light trapping properties of pyramidally textured surfaces." *Journal of Applied Physics* 62.1 (1987): 243-249.

به باریکه ی فرودی پس از ۶۰۰ تپ فرودی به ۴۰ درصد می رسد. در این حالت با توجه به آن که الکترون ها فرصت انتقال انرژی کسب کرده از تابش تپ لیزری به شبکه را ندارند، از سطح خارج شده و سطح هدف به دلیل افزایش بار مثبت دچار انفجار کولنی شده و ذرات از سطح خارج می شوند. در نتیجه، روی سطح ساختارهای میخه مانند تشکیل می شوند و افزایش شار انرژی، (9 KJ/m^2) باعث بیشتر شدن میخه ها و متمایز شدن آن ها از یکدیگر می شود. بازتاب از سطح در این حالت تا حدود ۸۸ درصد کاهش می یابد.

جهت بررسی ریخت شناسی سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. در شکل ۴ تصویر SEM سطح پس از اندرکنش تپ های با شار انرژی KJ/m^2 ۹ نشان داده شده است و همان طور که انتظار می رفت، ساختارهای میخه مانند روی سطح تشکیل شده اند.



شکل ۴: تصویر SEM سطح ویفر سیلیکون پس از تابش با تپ های لیزری فوق کوتاه

به این ترتیب اصطلاحاً سیلیکون سیاه در سطح تشکیل می شود که به دلیل وجود ساختارهای میخه مانند، تعداد دفعات بازتاب نور از سطح به مراتب افزایش پیدا می کند و از این رو طبق رابطه ی مربوط به سطح لامبرتین، ضریب جذب سطحی افزایش می یابد [۵]. در شکل ۵ تصویر میکروسکوپ نوری (بزرگنمایی ۱۰۰ برابر) از سطوح کندوسوز شده با تپ لیزری با شار انرژی های بسیار بزرگ تر از شار آستانه، نشان داده شده است. در این تصویر، تشکیل سیلیکون سیاه به وضوح مشهود است.